

Содержание

Грищенко Ю.В., Занавескин М.Л., Марченков А.Н.

Разработка метода расчета фактора корреляции рельефов подложки и пленочного покрытия по данным атомно-силовой микроскопии 1

Ротштейн В.П., Колубаева Ю.А., Меі Х., Марков А.Б., Найден Е.П., Оскомов К.В., Прядко Е.Л., Тересов А.Д., Шулепов И.А., Шулов В.А.

Влияние условий импульсного электронно-пучкового плавления систем Al (пленка)/Ti (подложка) на фазообразование и свойства поверхностных сплавов Ti-Al 7

Пустоваров В.А., Иванов В.Ю., Выпринцев Д.И., Швалев Н.Г.

Времяразрешенная люминесценция сцинтилляционных кристаллов $\text{LaBr}_3:\text{Ce}$ при возбуждении в ультрамягкой рентгеновской области 15

Сорокин Л.М., Фокин А.В., Калмыков А.Е., Черняев А.В.

Низкотемпературные свойства нанокompозита пористый кремний-индий 24

Елистратов Е.А., Кузнецов А.П., Масленников С.П., Протасов А.А., Школьников Э.Я.

Измерение параметров импульсного объемного разряда наносекундной длительности в воздухе атмосферного давления 31

Аульченко С.М., Замураев В.П.

Управление обтеканием крыловых профилей на трансзвуковых режимах посредством силового воздействия элементов поверхности на поток 39

Воронин П.В., Кривченко В.А., Иткис Д.М., Семененко Д.А., Рахимов А.Т.

Пленки нанокристаллического графита, синтезированные в плазме разряда постоянного тока, как материал для электрохимических конденсаторов 45

Макаренко А.В.

Мера синхронности многомерных хаотических последовательностей на основе их символического представления 53

Банщиков А.Г., Кошмак К.В., Крупин А.В., Соколов Н.С.

Стабилизация орторомбической фазы NiF_2 в эпитаксиальных гетероструктурах на подложках $\text{CaF}_2/\text{Si}(111)$ 61

Забродский В.В., Белик В.П., Аруев П.Н., Бер Б.Я., Бобашев С.В., Петренко М.В., Суханов В.Л.

Исследование стабильности кремниевых фотодиодов в вакуумном ультрафиолете 69

Буравлев А.Д., Абдрашитов Г.О., Цырлин Г.Э.

Молекулярно-пучковая эпитаксия $(\text{Ga},\text{Mn})\text{As}$ нитевидных кристаллов на поверхности $\text{GaAs}(100)$ 78

Лукашин В.М., Пашковский А.Б., Журавлев К.С., Торопов А.И., Лапин В.Г., Соколов А.Б.

Уменьшение роли поперечного пространственного переноса электронов и рост выходной мощности гетероструктурных полевых транзисторов . . . 84

Ивченко В.А.

Порог образования нанопор в ионно-имплантированной платине 90